

Procedeu de obținere a structurilor semiconductoare poroase care constă în aceea că pe suprafața semiconductorului se depune o mască, pe regiunile neacoperite se implantează ioni de energie înaltă, apoi masca se înlătură, iar suprafața semiconductorului se supune corodării electrochimice, caracterizat prin aceea că înainte de corodare, pe suprafața semiconductorului se depune un strat din material fotorezist.